四公開特許公報(A)

昭61-267734

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>		識別記号	<u> </u>		43公開	昭和61年(198	36)11月27日
G 02 F	1/133	1 1 8	D - 8205-2H F - 8205-2H				
		129	D - 7348 - 2 H B - 7348 - 2 H				
G 09 F	9/35		6810-5C	審査請求	未請求	発明の数 1	(全6頁)

到特 期 昭60-110667

砂出 顋 昭60(1985)5月23日

@発明者 曽根原 富雄

有賀 修二

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

の出 顋 人 セイコーエブソン株式

会社

20代理人 弁理士 最上 務

明 細 雪

1 猪明の名称 被品置级光学磁波

2 特許請求心超出

@発 明 者

相対する 2 枚の裏板間に強弱電性液晶組成物を 探持して成る痕晶パネルに、 進界を印加し該液晶 パネルの光散乱状態を側倒する液晶 電気光学復世 において、アクテイプマトリクス駆動手段を有す ることを特徴とする液晶 電気光学後進。

5発明の辞機な説明

〔産薬上の利用分野〕

本発明は独勝退性 液晶 組成物の 飲息 現象 を利用 した液晶 電気光学装置の 高情報 並化に関するもの である。

(発明の概要)

本発明は強弱選性液晶組成物の光散乱状態を印 加電場により制御する液晶電気光学装置において、 アクテイブマトリクス磁動手段を設慮したことに より。高情報並の表現を可能にしたものである。 (従来の技術)

強励 電性放晶の光飲乱状態を印加 電場によつて 制御する電気光学効果(以下、Ferroelectric Liguid Crystal Scattering 効果, P L B 効果 と称する)は、Ferroelectrica 59, P. 145~ 160, 1984 に配送されるように、単一セルに よる影動が確認されている。

(発明が解決しよりとする問題点)

しかし、前述の従来技術ではPLB効果が明瞭なしきい値をもたないため情報提現に対して、スタテック軟動された表示エレメントを複数個組合せる他なく、高情報量の表現は不可能であつた。

本発明はこのような問題点を解決するもので、 その目的とするところは、PLB効果を高情報量 表現に応用した液晶電気光字装置を提供すること にある。

(問題点を併決するための手段)

本発明の液晶 道気光学接近は、 F L B 効果を用いる液晶パネルの熱動手段としてスイッチング集

子エレメントを各投示値器に配したアクテイブマ トリクスを有することを特徴としている。

(作用)

本発明は単一セルでの動作のみ可能な B L B 効果を、アクティブマトリクスによつて駆動を行な りものである。アクティブマトリクスは各画案に対してスイッチング架子を有してかり、非常に短 かい選択時間であつても、各画案に配置されたスイッチング案子によつて 100 f に近いデューティー比での駆動が可能となる。このため P L B 効果を用いた感情報量表現可能な 底晶 電気光学装置が実現される。

(実施例)

以下、本発明について実施例に基づいて詳細に説明する。

実施例1

実施例1はアクテイプマトリクス業子として TBT(海膜トランジスタ)を用いたFLB効果 パネルの場合である。

軍1図は一部を取り出した斜視図である。各画

いているため、液晶層には数 11 200~数10m 300周 期の極性反転した世圧と直流電圧を印加する必要 かある。極性反転周期は液晶の分子運動の適度、 自発分布の大きさに依存している。本実施例の乗 件は約80℃に液晶パネルの温度を保ち液晶をカ イラルスメクチック相とした状態で5088の値 性反転電界をかけた。この値性反転電界は、第2 図に示すようにフィールド(反乱パネル全面を点 **順次、あるいは線順次にアドレスする時間)①。 ө毎にTPTのソース配線切にトランスミツショ** ンゲート個を通じて加わるビデオ信号のを反転し て作られる。これを散乱信号のと称し、第2図中 に斜線で示した。共通電信包はこのときビデオ信 今の圧圧中間の重位をとつている。したがつて、 飲乱状態に対応した画業には、フィールド毎に低 性の反伝した電位が書き込まれ、強弱電性液晶に は散乱を誘起する反転電圧が加わることにたる。

とれに対し直流運圧の印刷はビデオ信号をフィールド低に反転せずに与えればよい。 第 2 図のビデオ信号の母の部分である。

果に対応して国家電電①、TPT③が設置され、 対向高板③上の共通電電④との間に強誘電性板品 組成物③をはさんだ構成となつている。

本実施例の場合、TPT③は石英ガラス基根上のポリシリコンTPTであり、市販のアクテイプマトリクス収収品ポケットテレビに用いられているものと同様に形成されたものである。他の構成部材についても同様である。

強勝 単性液晶組成物 ⑤ は 本実施例の場合、 D O B A M B O を用い、 基板の配向処理として有破膜のラビング処理を施している。 パネル間のギャップは 2 △ A = である。 ギャップは必要となる散乱の大きさ、 動物電圧によつて通算過択される。

また同じギャップでも光路を2倍にしより強い 光飲乱を得るために、画業電低①あるいは共通電 低②を光反射性電低、例えばアルミニウムや磁の ような金銭厚膜電低にすることも有効である。

次に駆動について説明する。第2回はFLS効果TFT成品パネルの駆動例を示す図である。本 実施例の場合、BOBAMBCのFLS効果を用

つまりビデオ信号値の発生は、2フイールド毎の信号フィールド的にかいて、投示データに従つて Ov と Vy の間で選択され、さらに全 O N フィールド値では Vy または Oy が 加わるようにして行な

さらにとれらは成晶の劣下を妨止するために、 Nフィールド毎に反転されている。第2図中の® 及び⊌がこれを示している。

和2図中にはゲート配線印像の信号を省略して あるが、これは市成のポケット被結テレビに用い られているものと同様、順次選択されるようたパルスが印加される。これらは日経エレクトロニクス9月10日号(1984)P211を参照され たい。

また第2図のビデオ信号は説明を簡単にするためのマあるいは V v O 2 値信号を加えたが、選圧扱中 O から V v の間で変調し、散乱強度の変化を与えることができる。この時のビデオ信号の例を第3図に示す。

以上述べたよりにBLB効果をTPTアクティ

プマトリクス製動手段により多個素の発現に応用 することが可能となつた。 本実施例はTPTを採 用した例であるが、同様な5端子スイッチ業子で あれば応用可能である。また界面配向によるメモ リー性などが残る場合は必ずしも個素は低に直流 世圧と交流 低圧のいずれかが常に印加されている 必要はない。

夹宽例 2

実施例 2 はアクティブマトリクス祭子として 2 端子双方向性スイッチング祭子である M I M (金以一絶歌は一金銭)ダイオード⑪を用いた場合である。

ルの2フレーム交流方式と同等である。データ線 信号(編6凶(a), (b))は、全ONフレーム図と信 **ヴァレーム哲を女互にとるようになつている。金** O N フレーム値では、2フレーム交流方式の O N レベルをとる。信号フレーム@では、 散乱つまり 交流選圧とする場合は O N レベルゆ、非敗乱すな わち直旋進圧とする場合はOFBレベル留をとる よりにしている。信号フレームは通常の単端マト リクス版旅パネルと同じ河允方である。とのよう にして画楽には第6図(10)、(6)に示す 進圧が印加さ れる。鹵朮(4,3),鹵朮(4,4)に加わる 進圧で画素回路での作動が異なるのは、幼の選択 期間である。面果(4,3)は匈の選択朔間に負 傾に新たに書き込まれるのに対し、劇景(4.4) は幼の選択期間にHIHダイオードロアアしたま まであり、強磅電性液晶瘤は正側の電圧を保持し 鋭ける。この結果直流は圧と交流は圧の提示デー 々に従つた変調が可能となつた。本異症例ではフ レームの反転過吸紋は実施内1と何じく508m とした。また仮晶の劣下を妨止するためにNフィ

な双方向性の非線型特性を有している。 M I M ダイオードの製造法、パネル構成は、特別的 5 5 ー 1 6·1 2 7 3 や Proceedings of JAPAN DISPLAY '83 P.404 に配送されるものと同等である。

次に慰めについて説明する。 第6四は P L 8 効果 M I M 液晶パネルの認動 例を示している。 (a) は 3 列目のデータ値 号 破 形 、 (b) , (e) は それぞれ 面 派 (4 , 3) , (4 , 4) に 加わる 電 圧 波 形 、 (c) は それ ぞれ 面 派 の 液晶 層 (4 , 3) , (4 , 4) に 加わる 電 電 低 信 号 波 形 で ある。 これ らの 信 号 強 生 は 従来の 単 純 マ ト リ ク ス 型 液 晶 炎 示 矢 値 と 同 様 に 行 な う ことが できる。

ここで各借号放形について詳しく説明する。 PL8効果は実施例1でも述べたように交流 選圧 と直流 選圧の切換が必要である。 本実施例の場合、 フレーム(全國業をアドレスする時間) 100 , 200 年 に低性反転が可能とする必効とした。 走金 遺価信 号(罪6凶(8)) は通常の単純マトリクス液晶パネ

ールド毎に据 6 図の信号政形をすべて反転し、反転した直旋選近の印加をすることもできる。

以上は簡単のために 2 値級規の場合について述べたが、階調機領も可能である。 これは、 敵乱強 匿 いべんの変調を 0 N レベル 必と 0 F F レベル の の間で 擬中変調する ことによつて実現される。 こ の場合の型動は実施別 1 の 3 選子の場合と類似と なる。

以上述べたように2端子双方向性スイッチング ス子の一例としてMIMダイオードをPLS効果 の必動果子に採用することによつて、多画異の表 現か可能となつた。

実施例 3

実施例3は必動マトリクス架子に複数のスイッテング案子を用いたFLB効果液晶パネルの場合である。

バネルの構成はアクテイプマトリクス基板と強 講覚性液晶組成物層、対向基板であり実施例 1、 実施例 2 と同じであるので省略する。第 7 図 (a) に 一面業の機能ダイヤグラム、棋 7 図 (b) にトランジ スタを2個用いた場合の等価回路図を示す。這択回路では、100円では、2

次に簡単に動作を視明する。ソース線のとゲート配制には画業選択のためのアドレメングパルスが印加され、一画面の生成毎に1回当事画業が選択される。選択された際の表示情報は、ソース線から保持用キャパンタ砂に選圧として与えられ、保持用キャパンタは次の選択さで情報を保持して

インピーダンスを利用することによつて、簡単な 2 つのトランジスタ構成で P L B 効果に必要な交 能に直旋電圧の切換が可能となつた。

突線のマトリクス表子は、突施例1と同じく TFTや、81基板上に形成されるMOSトランジスタによつて構成される。またこれらの脳素選択の手法は、前述した液晶ポケットテレビと同等に行なつている。

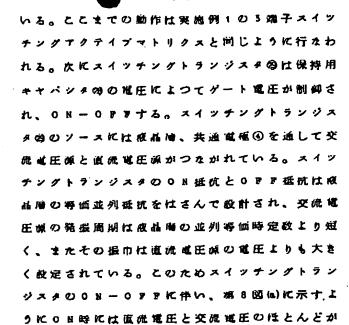
さらに液晶の劣下を妨止するために、N フィールド母に直飛電圧原30の値性を反転し、N フィールド母の交流戦動としてもよい。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、FLS効果をアクテイブマトリクスによつて製造することによつて、FLS効果の使れた特性を持つ多画素を有した高情報量対応の電気光学級職を実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はFLB効果TFT被晶パネルの漸視図。 第2図はFLS効果TFT被晶パネルの幽幽図。



直飛電圧成分が印加される。 このように液晶層の

液晶磨印加速圧労となり、交流電圧の張中が直流 電圧より大きいため、液晶層にはFL 8 効果の数

私に十分な交流世圧がかかる。OFF時には第 B

図句に示すよりに、交流成分の大部分はスイッチ

ングトランジスタ印加電圧雪となり、収益層には

期 3 図は張巾変調した場合のビデオ信号図。

第4図(a) 柱をLS効果以IU 版品パネルの画案 等価回路図。

第4図(b)はFLS効果MIM液晶パネルの斜視図。

第5図はMIMの電流一電圧特性図。

城る図はFLB効果MIM液晶パネルの総動波 形図。

病7図(a)は1面系の破能ダイアグラム図。

期 7 図 (D)は 2 トランジスタによる毎価回路図。

第8図(a)、(b)は液晶瘤とトランジスタに印加される電圧波形図。

1…面景电低

2 · · · T F T

4 … 共通遺籍

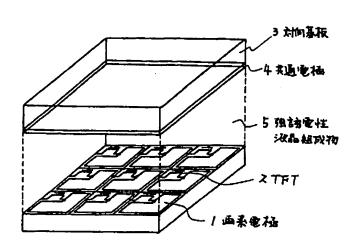
5 …強勝電性液晶組成物

1 7 ··· M I M

2.4 …通択回路

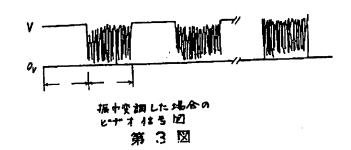
2 5 …保持回路

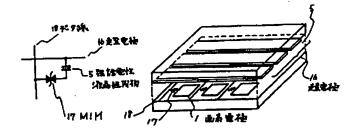
2 6 … スイッチ回路



FLS女裸 TFT液晶 パネルa 斜視図

第 1 図



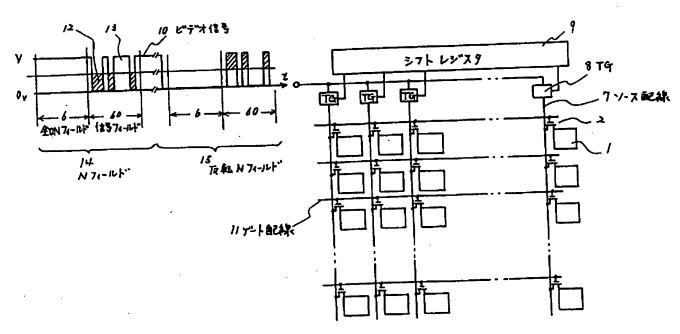


PLS如果HIH 沙路水利V

FLS划煤HIH浓品 小和LA针和国

第 4 図(4)

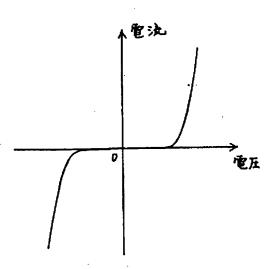
第 4 図い



FLS効果TFT泌晶パネルa配動 図

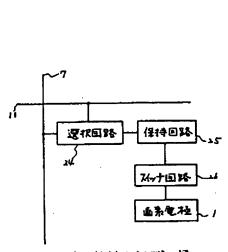
第 2 図

特開昭61-267734 (6)



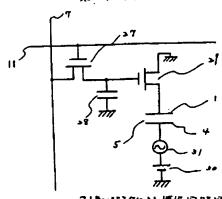
MIMa電流-電圧特性図

第 5 図

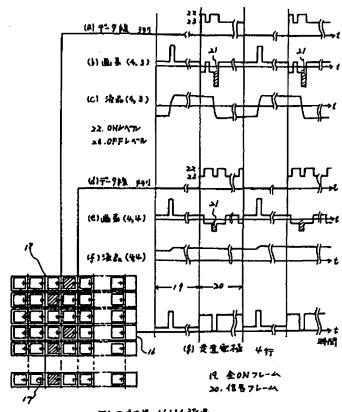


1画来の被蛇がアナウム国

第7図(4)

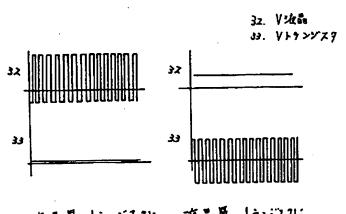


2 トランジスタによう 等価回路回 第 7 図 (b)



FLS 効果 MIM 液晶 パネルの 配動 収制 図

第 6 図



液晶層≥トランジスチト 炉加zれぬ電圧速形型 第 8 図 (a)

液晶層とトランジスタバ 切加される電圧波形図 第8図(b)